**Голяшов Владимир Андреевич. Физико-химические свойства и электронная структура поверхности трехмерных топологических изоляторов на основе халькогенидов и халькогалогенидов висмута и сурьмы;[Место защиты: ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук], 2021**